This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

62-082516

(43)Date of publication of application: 16.04.1987

(51)Int.CI.

G11B 5/85 C23C 14/14

(21)Application number: 60-221860

(71)Applicant: VICTOR CO OF JAPAN LTD

(22)Date of filing:

07.10.1985

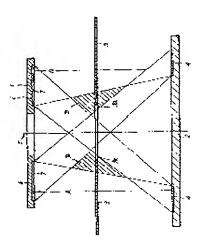
(72)Inventor: ABE TOSHIRO

NISHIHARA TOSHIKAZU

(54) PRODUCTION OF MAGNETIC DISK

(57)Abstract:

PURPOSE: To improve both the magnetostatic characteristics and the electromagnetic conversion characteristics of a magnetic disk, by forming a magnetic foundation film and/or a magnetic film with only those evaporation particles that fly over the virtual center axial line of a substrate and attach onto the substrate. CONSTITUTION: An aluminum substrate 1 for a magnetic disk, a target 2 and a mask 3 are distributed as shown in a diagram. Then a circular magnetron sputtering process is carried out under the conditions of 5mmTorr argon gas pressure. The only Cr particles that fly over a virtual center axial line 5 of the substrate 1 are coated on the surface of the substrate 1 among those Cr particles flying from an errosion area 4. Thus a Cr film 6 serving as a magnetic foundation film is obtained. Then only the Co-Ni particles that fly over the line 5 are coated on the surface of the film 6 among those Co-Ni particles flying over the area 4. Then a Co-Ni magnetic film 7 is obtained. In such a way, a magnetic disk is produced.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

19 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62-82516

⑤Int Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

④公開 昭和62年(1987)4月16日

G 11 B 5/85 C 23 C 14/14 C - 7314 - 5D 7537 - 4K

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

図発明の名称 磁気ディスクの製造法

到特 願 昭60-221860

砂発明者安部 俊郎砂発明者 西原 敏和

39発 明 有 四 原 取 和 ①出 願 人 日本ビクター株式会社

の出 願 人 日本ビクター株式会社の代 理 人 弁理士 字高 克己

横浜市神奈川区守屋町 3 丁目12 日本ビクター株式会社内 横浜市神奈川区守屋町 3 丁目12 日本ビクター株式会社内 横浜市神奈川区守屋町 3 丁目12番地

明 細 4

1. 発明の名称

磁気デイスクの製造法

2. 特許請求の範囲

基板上に磁性下地膜及び/又は磁性膜をスパック法によつて形成して磁気デイスクを製造する場合に、実質上前記基板の中心軸仮想線を越えるように飛来する磁性下地膜及び/又は磁性膜を構成する蒸発粒子のみが基板上に被着されて磁性下地膜及び/又は磁性膜を形成するようにしたことを特徴とする磁気ディスクの製造法。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、磁気デイスクの製造法に関するもの である。

「従来技術とその問題点」

従来より、例えば環状マグネトロンスパツタ法 を用いて金属海膜型の磁気デイスクを製造するこ とが試みられている。

しかし、これまでの環状マグネトロンスパツタ

法を用いて製造された磁気デイスク(磁性下地膜である非磁性の Crの膜厚は 3000~4000 Å、磁性膜である Co-Niの膜厚は 700 ~ 800 Å)は、Hc が 795 エルステツド、Rs が 0.71、S*が 0.74、分解能が 91.9 %、孤立再生波形の半値巾Wio が 1.96 μm、密度特性 Dio が 16.82 KBPIであるといつたように、その静磁気特性及び電磁変換特性が充分満足できるものでもない。

(発明の開示)

本発明者は、環状マグネトロンスパッタ法によって磁気ディスクを製造する実験において、ふとした手違いからこれまでの環状マグネトロンスパッタ法と多少異なる条件が施されたことに気付かずにそのまま実験が行なわれ、そしてこのようにして得られた磁気ディスク(磁性下地膜であるCoの股厚は300~4000Å、磁性膜であるCo-Niの股厚は700~800Å)は、Hcが1400ェルステッド、Rsが0.74、S*が0.84、分解能が95.7%、Wioが1.62μm、Dioが23.0 KBPI といつたように、その節磁気特性及び電磁変換特性共に大

巾に向上したものであることに遭遇した。

そこで、本発明者は、静磁気特性及び電磁変換特性が大巾に向上した上記の磁気ディスクの研究を行なつた結果、この磁気ディスクは、その磁性下地膜及び磁性膜が円周方向に配向しており、このような配向性によつて静磁気特性及び電磁変換特性が、これまでの配向していない磁気ディスクのものより大巾に向上するものであることを究明した。

そして、さらに研究を続け、磁性下地膜及び磁性膜が今回に限つて何故円周方向に配向していたのかを追究した結果、環状マグネトロンスパッタ法の実施に際してのマスクがこれまでのものと異なつていたことを見い出したのである。

そこで、このような知見を基にして同様な実験を繰り返した結果、環状マグネトロンスパッタに際してのマスクによつて磁性下地膜及び磁性膜の 円周方向における配向性が大きく左右されること を究明したのである。

すなわち、図面に示すように、磁気デイスクの

面に示すような手法で行なつて磁性下地膜が円周 方向に配向するようにしてかけば、この磁性下地 膜上に形成される磁性膜の形成に際しては、図面 に示すような手法を採用せず、これまでの環状マ グネトロンスパッタ法と同様な手法で行なつても、 磁性下地膜の影響を受けて磁性膜は円周方向に配 向する。

又、言うまでもないことであるが、磁性膜が円周方向に配向していれば、この磁気ディスクの砂磁気特性及び電磁変換特性は向上するものであるから、磁性下地膜の形成に際しては図面に示すよっな手法を採用せず、磁性膜を採用しても良いものである。

以上のような知見を基にして本発明は為し遂げられたものであり、すなわち基板上に破性下地段及び/又は磁性膜をスパッタ法によって形配を殴盗する場合に、実質上前記基での中心軸仮想線を越えるように飛来する磁性下地膜及び/又は磁性膜を構成する蒸発粒子のみ態を板上に被着されて磁性下地膜及び/又は磁性膜を

つまり、中心部に円孔3 a を設けたマスク3の円孔3 a 端が、図面中斜線Bで示す領域中に存在するようマスク3を基板1とターゲット2との間に配置して環状マグネトロンスパツタを行ない、 強性下地膜及び磁性膜を形成すれば、この磁性下 地膜及び磁性膜は円周方向に配向したものとなる ことを確認したのである。

尚、これまでにおいては、磁性下地膜及び磁性 膜の形成に際しては共に同じように行なうことし か述べなかつたが、磁性下地膜の形成に際して図

形成するようにした磁気デイスクの製造法を提供 するものである。

(実施例)

上記のようにして初られた磁気デイスクの特性 を調べると、Hc が 1 4 0 0 エルステッド、Rs が 0.7 4、S*が 0.8 4、分解能が 9 5.7 %、W...が 1.62 μm、 D. 。 が 2 3.0 КВР 1 であり、その阶級気特性 及び電磁変換特性は衝めて良好なものである。

〔 効果 〕

4. 図面の簡単な説明

図面は、本発明に係る磁気ディスクの製造法の

実施に際して用いられる環状マグネトロンスパッ タ装置の要部の概略を示す説明図である。

1 … 基板、 2 … ターゲット、 3 … マスク、

4 … エロージョンエリア、 5 … 中心軸仮想線、

6 ··· Cr 膜(磁性下地膜)、

7 ··· Co-Ni 磁性膜(磁性膜)。

特許出願人 日本ピクター株式会社 代 理 人 字 高 克 ご

